

低温触媒CVD装置の開発

プラズマを用いずに高速で大面積に薄膜形成可能な触媒CVD法において、薄膜形成温度を従来の200℃以上から、100℃以下まで低減する技術を開発します。

〈実施機関〉

研究者	石川県工業試験場
事業化推進者	株式会社 石川製作所
共同研究機関	北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興事業団：研究成果活用プラザ石川

〈内容〉

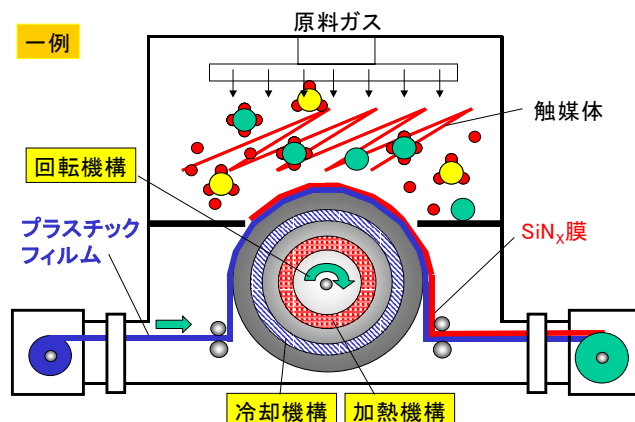
電子デバイス：湿気、汚染、腐食、衝撃

→ 高信頼性のための保護膜 (SiN_x)

保護膜形成に関する要求

- 低温形成
- 高耐湿性
- 高耐食性

	従来	次世代
被覆対象	Si	プラスチック (非耐熱材料)
形成温度	300~500℃	80℃

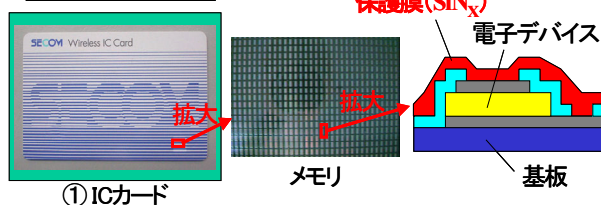


プラスチックフィルム用低温触媒CVD装置

〈期待される効果〉

半導体・ディスプレイ製造工程の省力化が図られるのはもちろんのこと、新たにプラスチックフィルムへの適用なども期待され、適用範囲の広い普遍的な低価格・低温コーティング技術を提供することができます。

低温 SiN_x の応用例



②有機ELディスプレイ
(プラスチック基板)



③超長寿命磁気テープ
(プラスチックフィルム)